[®] 日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-196834

⑤Int. Cl. 4

庁内整理番号 識別記号

43公開 平成1年(1989)8月8日

H 01 L 21/316

6708-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

電気泳動装置 60発明の名称

> 願 昭63-22234 21)特

願 昭63(1988) 2月2日 22)出

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 健司 给 木 70発 明 者

补内

富士電機株式会社 勿出 頣 λ

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

弁理士 山 口 巖 74代 理

1. 発明の名称 電気泳動装置

2. 特許請求の範囲

1) ガラス 微粉 末 懇 瀬 液 を 収 容 す る 円 筒 状 容 器 が 軸 心の周りに回転可能であり、該容器の軸心部に外 面に半導体素体を支持する陰極体、容器の周壁内 面に陽極板がそれぞれ固定されたことを特徴とす る電気泳動装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体素子の表面安定化のためにガ ラス微粉末を付着させパッシベーションを行うた めに用いる電気泳動装置に関する。

〔従来の技術〕

パッシベーション材料としてガラスを用いる場 合、従来は電気泳動法によりガラス微粉末を半導 体素体表面に付着させる方法が、その後の焼成で 均一なガラス膜を形成できるので採用されている。 第2図はそのための装置を示し、電着槽1の中に ガラス微粉末をアルコールに懸濁させた液2を収

容し、この液中に半導体ウェハ3を支持した陰極 板4とそれに平行に対向する陽極板5を浸漬し、 アンモニアガスを導入管 6 より噴出させながら両 電極間に直流電圧をかけることにより電気泳動法 を行う。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、第2図のような装置で電気泳動法を 行うと、粒径の大きい例えば10畑を超える径のガ ラス粉末も半導体ウエハ3に付着しやすく、焼成 時に空隙の少ない滑らかなパッシベーション膜が できにくいため、特性の安定した素子が製造しに くいという欠点があった。しかもこの現象は、処 理枚数が増加するほど顕著になるため、処理枚数 が制限され、装置の利用効率を高めることができ なかった。粒径の大きい粉末を付着させないため には、アルコールに懸濁させるガラス粉末を微細 化すればよいが、そのためにはグラインド作業を 多くしなければならず、不純物が多く入る欠点が 生ずる。

本発明の課題は、粒径の大きいガラス粉末も混

じた懇適液を用いても、比較的粒径の小さいガラス粉末を選択的に半導体素体の表面に付着させることができ、空隙の少ない滑らかなバッシベーション膜を形成して特性の安定した半導体素子の製造に用いることのできる電気泳動装置を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

上記の課題を解決するために、本発明の装置はガラス微粉末懸濁液を収容する円筒状容器が軸心の周りに回転可能であり、容器の軸心部に外面に半導体素体を支持する陰極体、容器の周壁内面に陽極板を固定されたものとする。

(作用)

ガラス微粉末態濁液を収容した容器を回転させることにより、遠心力で粒径の大きいガラス粉末が容器の外側に移動し、容器の回転中心部に位置する降極体の外面にある半導体素体には粒径の小さいガラス粉末だけが付着する。

〔実施例〕

第1図(1), (1)は本発明の一実施例を示し、(1)は

時に空隙が少なく気泡率の少ない滑らかなパッシベーション膜が得られた。その結果、逆方向のもれて流が小さく、逆方向特性のソフトなものが少なくなって耐圧が向上し、組立後の高温電圧印加試験でもソフトな逆方向特性に劣化するものも少なくなった。

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

第1図(a), (b) は本発明の一実施例の装置を示し

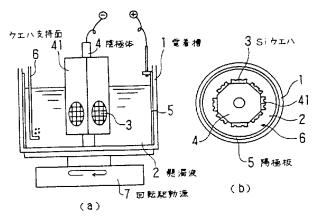
断面図、1のは平面図であり、第2図と共通の部分 には同一の符号が付されている。円筒状の電着槽 1には内側に陽極板5が張られており、底面には 電源に接続される中心軸の周りに八角柱状の半導 体ウエハ3の支持面41を有する陰極体4が固定さ れている。 陽極板 5 と支持面41の間隔は 2 ~ 4 cm とする。この電着槽1は駆動源7により陰極体を 中心として回転させることができる。既にエッチ ングによりメサ溝を形成したウェハ3をこの装置 の各支持面41に取付けたのち、ガラス微粉末を懸 濁させたイソプロピルアルコールを槽1内に入れ、 両極 4 . 5 間に50~500 Vの直流電圧を印加し、 ガス導入管6からアンモニアガスを吹き込みなが ら、電着槽を20~200rp■の回転数で回転させて電 気泳動法を行う。このあとメサ溝の内面を除くウ エハ面に付着したガラス粉末を除去してから焼成 を行うと、メサ溝内に露出したPN接合を保護す るガラスパッシベーション膜が得られる。

第1図の装置により電気泳動法により付着した ガラス微粒子は粒径が7~8m以下であり、焼成

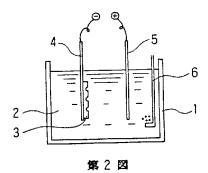
(a) は斯面図、 (b) は平面図、第 2 図は従来装置の断面図である。

1: 電着槽、2: ガラス微粒子懸濁液、3:シリコンウエハ、4: 陰極体、41: ウエハ支持面、5: 陽極板、7: 回転駆動源。

八压人升度士 山 □ ↓



第1図



PAT-NO: JP401196834A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01196834 A

TITLE: ELECTROPHORESIS DEVICE

PUBN-DATE: August 8, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SUZUKI, KENJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

FUJI ELECTRIC CO LTD N/A

APPL-NO: JP63022234

APPL-DATE: February 2, 1988

INT-CL (IPC): H01L021/316

US-CL-CURRENT: 204/623

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a passivation film having a small air bubble rate by securing the cathode of an electrophoresis device to the center of a vessel and the anode to the inner wall of the vessel, and rotating the vessel.

CONSTITUTION: An anode plate 5 is extended inside a cylindrical electrodeposition tank 1, and a cathode 4 having the supporting face 41 of a

octagonal columnar semiconductor wafer 3 is secured to the periphery of a central shaft connected to a power source in the bottom. The tank 1 is rotated by a drive source 7 with the cathode as a center. After the wafers 3 are attached to the supports 41, isopropyl alcohol suspended with fine glass powder is poured in the tank 1, a voltage is applied between both electrodes 4 and 5, the tank 1 is rotated while blowing ammonia gas from a gas tube 6 to perform an electrophoresis method. Only fine glass particles disposed at the small center of centrifugal force is deposited on the wafer 3 supported on the cathode 4. A passivation film having small air bubble rate is formed.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio